

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日
Date of Application:

2002年 8月 8日

出 願 番 号
Application Number:

特願2002-231396

[ST.10/C]:

[JP2002-231396]

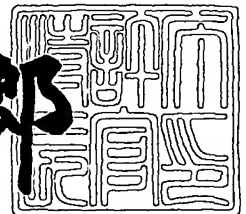
出 願 人
Applicant(s):

松下電器産業株式会社

2003年 6月 2日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田信一郎



出証番号 出証特2003-3042669

【書類名】 特許願

【整理番号】 2176040013

【提出日】 平成14年 8月 8日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H04B 1/40

【発明者】

 【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式
 会社内

 【氏名】 井上 竜也

【発明者】

 【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式
 会社内

 【氏名】 徳永 英晃

【特許出願人】

 【識別番号】 000005821

 【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100097445

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 岩橋 文雄

【選任した代理人】

 【識別番号】 100103355

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 坂口 智康

【選任した代理人】

 【識別番号】 100109667

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 内藤 浩樹

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011305

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9809938

【書類名】 明細書

【発明の名称】 高周波デバイス

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 アンテナ端子と、前記アンテナ端子に接続した共用器を備え、前記アンテナ端子と前記共用器間の信号ラインと並列にバリスタおよびインダクタを接続した高周波デバイス。

【請求項 2】 バリスタとインダクタは、一体化された素子である請求項 1 に記載の高周波デバイス。

【請求項 3】 アンテナ端子、バリスタ、インダクタは、導電体層とセラミック層とを積層した積層セラミック回路基板で構成する請求項 1 に記載の高周波デバイス。

【請求項 4】 インダクタのインダクタンスは 5 0 n H 以下である請求項 1 に記載の高周波デバイス。

【請求項 5】 バリスタの静電容量は、1 0 p F 以下である請求項 1 に記載の高周波デバイス。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、例えば携帯電話などの移動体通信機器に用いるものであり、特にアンテナ端子から侵入する静電気からフィルタなどの高周波部品を保護することのできる高周波デバイスに関するものである。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

最近、携帯電話などの移動体通信機器においては、アンテナ端子から侵入する静電気によって、内部の電気回路を破壊する危険があることが認識されている。静電気は、1 ナノ秒以下の速度でかつ数百～数キロボルトという高電圧がかかるからである。

【0 0 0 3】

そこで、特開 2 0 0 1 - 1 2 7 6 6 3 号公報においては、図 7 に示されるよう

に、アンテナ端子 1 とスイッチ回路 2 との間にコンデンサとインダクタとからなるハイパスフィルタ 3 を接続し、回路 2 の保護を図っている。

【0 0 0 4】

【発明が解決しようとする課題】

携帯電話などの移動体通信機器においては、年々小型化が進み、中に収納される高周波デバイスも小型化が求められている。

【0 0 0 5】

上記ハイパスフィルタ 3 において、通過帯域外減衰量を大きくしようとする、コンデンサとインダクタとを多段に接続しなければならない。また、多段に接続すると、挿入損失が大きくなるだけでなく高周波デバイスも大きくなってしまふ。従って、限られた大きさの中では、ある程度の特性しか得られない。

【0 0 0 6】

しかしながら、静電気のような信号通過帯域近傍の周波数の高電圧雑音が侵入すると、このハイパスフィルタ 3 を通過し、アンテナ端子 1 に接続した回路 2 に侵入して破壊してしまう恐れがある。

【0 0 0 7】

そこで本発明は、たとえ静電気のような信号通過帯域に近い周波数の高電圧雑音が侵入したとしても、アンテナ端子の後に接続された回路を保護することのできる高周波デバイスを提供することを目的とするものである。

【0 0 0 8】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、以下の構成を有するものである。

【0 0 0 9】

本発明の請求項 1 に記載の発明は、特に、高周波デバイスにおいてアンテナ端子と共用器間の信号ラインと並列にバリスタおよびインダクタを接続するものであり、アンテナから侵入した静電気をインダクタにより、グラウンドにバイパスさせると同時に、インダクタで除去しきれない立ち上がりの高周波成分をバリスタによって吸収することにより、共用器を含む回路を保護することができる。

【0 0 1 0】

本発明の請求項 2 に記載の発明は、特に、バリスタとインダクタの両方の機能を有する一つの素子を用いるものであり、部品点数の削減、実装面積の低減および実装コストの低減ができ、各種移動体通信機器への使用範囲を広げることができる。

【 0 0 1 1 】

本発明の請求項 3 に記載の発明は、特に、高周波デバイスの各種機能を設けた積層セラミック回路基板の内部にインダクタ機能およびバリスタ機能を設けたものであり、小型化、低背化することができ、各種移動体通信機器への使用範囲を広げることができる。

【 0 0 1 2 】

本発明の請求項 4 に記載の発明は、特に、インダクタンスが 50 nH 以下のインダクタを用いるものであり、より確実に回路の保護を行うことができる。

【 0 0 1 3 】

本発明の請求項 5 に記載の発明は、特に、バリスタの静電容量を 10 pF 以下とするものであり、より確実に回路の保護を行うことができる。

【 0 0 1 4 】

【発明の実施の形態】

(実施の形態 1)

以下、実施の形態 1 を用いて、本発明の特に請求項 1, 4, 5 に記載の発明について説明する。

【 0 0 1 5 】

図 1 は、実施の形態 1 における高周波デバイスのブロック回路図であり、例えば欧州携帯電話規格の GSM 携帯電話におけるアンテナ共用器として用いることができる。図 1 において、10 はアンテナ端子、11 はアンテナ端子 10 に接続した共用器であり、GSM 帯の送、受信の周波数成分を分波する役目を持つ。共用器 11 は移相器 14 と SAW フィルタ 12, 13 で構成されており、送信側端子 31 および受信側端子 32 が接続されている。

【 0 0 1 6 】

さらに、アンテナ端子 10 と共用器 11 の信号ラインと並列に 3 pF の静電容

量を有するバリスタ 2 1 と 18 nH のインダクタンスを有するインダクタ 2 2 が配置されている。このバリスタ 2 1 とインダクタ 2 2 の他端側はグランド端子 2 3 に接続されている。

【 0 0 1 7 】

バリスタ 2 1 は静電容量が 10 pF 以下でできるだけ小さい方が静電気除去効果を小さくせずに、通過帯域の挿入損失の増大を防ぐことができる。 10 pF より大きいと通過帯域の挿入損失を小さくすることが困難であるので好ましくない。またできるだけ小さい方が良いのであるが、 1 pF 以下であるとバリスタ 2 1 自身の静電気耐量が小さくなり回路保護効果の持続性が落ちるので好ましくない。従って、 $2\sim 5\text{ pF}$ のものを用いることが好ましい。

【 0 0 1 8 】

また、インダクタ 2 2 のインダクタンスは 50 nH 以下とすることにより、静電気除去効果は大きくなる。 50 nH を越えると、インダクタを通過する高周波成分が増えるので好ましくない。また、信号通過帯域の挿入損失を小さくできるので 3 nH 以上とすることが好ましい。

【 0 0 1 9 】

このような構成の高周波デバイスにより、信号通過帯域の挿入損失を大きくすることなく、共用器 1 1、特に SAW フィルタ 1 2、1 3 を確実に保護することができる。

【 0 0 2 0 】

本実施の形態の高周波デバイスの比較のために、図 4 に示すようにハイパスフィルタ 5 0 を使用した高周波デバイスを準備する。他の構成は図 1 と同様である。図 4 において、ハイパスフィルタ 5 0 は、信号通過帯域の挿入損失を考慮すると、インダクタ 5 1 のインダクタンスを 100 nH 程度に、コンデンサ 5 2 の静電容量を 33 pF 程度にする必要がある。しかし、静電気がアンテナ端子 1 0 から侵入した場合、通過帯域に近い高周波の高電圧成分を十分に除去できない。また、これより小さなインダクタンスのインダクタを用いると通過帯域の挿入損失が大きくなる。さらに、コンデンサの静電容量が 33 pF と大きいため、通過帯域に近い高周波成分を除去することができない。

【 0 0 2 1 】

図 5、図 6 に本実施の形態の高周波デバイスと比較例の高周波デバイスに対し、8 k V の静電気をアンテナ端子 1 0 に接触放電した時、共用器 1 1 以降の回路にかかる電圧を示す。

【 0 0 2 2 】

本実施の形態の高周波デバイスにおいては、図 5 に示すように、数ナノ秒の間に 2 4 0 V 程度の電圧しかかからないが、比較例の高周波デバイスにおいては、図 6 に示すように数ナノ秒の間に 9 5 0 V 程度の電圧がかかっている。

【 0 0 2 3 】

本実施の形態の高周波デバイスは、比較例の高周波デバイスと比較すると、加わる電圧は $1/4$ 程度となり、十分な電圧降下が行われていることがわかる。

【 0 0 2 4 】

つまり、アンテナ端子 1 0 と共用器 1 1 の信号ラインと並列にバリスタ 2 1 とインダクタ 2 2 を接続することで、通過帯域の挿入損失を大きくすることなしに、静電気などの高電圧雑音をインダクタ 2 2 によってグランド端子 2 3 にバイパスさせると同時に、インダクタ 2 2 で除去しきれない立ち上がりの高周波成分をバリスタ 2 1 によって吸収することで共用器 1 1 以降の回路に高電圧がかからず、必要な信号のみを送信することができる。

【 0 0 2 5 】

従って、高電圧雑音により悪影響を受ける可能性の高い共用器 1 1、特に S A W フィルタ 1 2、1 3 を確実に保護し、優れた信頼性を有する高周波デバイスを得ることができるのである。

【 0 0 2 6 】

(実施の形態 2)

以下、本実施の形態 2 を用いて、本発明の特に請求項 1、2 について説明する。

【 0 0 2 7 】

図 2 に本実施の形態 2 における高周波デバイスの断面図を示す。その構成回路は実施の形態 1 で示したものと同様であるので説明を省略する。

【 0 0 2 8 】

図 2 において、4 0 は積層セラミック基板であり、セラミック層 4 1 と導体パターン 4 2 を交互に積層することにより、内部及び外周面にアンテナ端子 1 0、移相器 1 4、送信側端子 3 1 および受信側端子 3 2 を形成している（図示せず）。そしてこの積層セラミック基板 4 0 の表面は SAW フィルタ 1 2、1 3、バリスタ 2 1 およびインダクタ 2 2 を実装し、図 1 に示す回路を実現している。

【 0 0 2 9 】

従って、実施の形態 1 と比較すると、高周波デバイスを一体化することで小型化ができ、移動体通信機器への適用範囲が広がることとなる。

【 0 0 3 0 】

なお、バリスタ 2 1 とインダクタ 2 2 は、セラミック層と導電体層とを積層して一体形成し、一つの素子とすることで、高電圧雑音からの保護効果は同様にしたまま、部品点数の削減、実装コストの低減ができる。

【 0 0 3 1 】

（実施の形態 3）

以下、本実施の形態 3 を用いて、本発明の特に請求項 3 に記載の発明について説明する。

【 0 0 3 2 】

図 3 は、本実施の形態 3 における高周波デバイスの断面図である。その構成回路は実施の形態 1、2 で示したものと同様であるので説明を省略する。

【 0 0 3 3 】

本実施の形態 3 と実施の形態 2 との相違点は、バリスタ 2 1 およびインダクタ 2 2 の形状である。

【 0 0 3 4 】

本実施の形態 3 においては、図 3 に示すように、セラミック層 4 1 と導体パターン 4 2 とを積層した積層セラミック基板 4 0 の内部及び外周面にアンテナ端子 1 0、移相器 1 4、送信側端子 3 1 および受信側端子 3 2 を形成している（図示せず）。また、積層セラミック基板 4 0 を形成する際、インダクタ 2 2 を形成するとともに、バリスタ材料で形成したセラミック層 4 4 と内部電極 4 5 も同時に

積層することにより、バリスタ 2 1 も内部に形成している。そしてこの積層セラミック基板 4 0 は、表面に凹部を有するとともにこの凹部に S A W フィルタ 1 8 を実装し、図 1 に示す回路を実現している。また、凹部をふた 4 3 で封止している。なお、S A W フィルタ 1 8 は、一つのパッケージ内に S A W フィルタ 1 2, 1 3 を設けたものである。

【 0 0 3 5 】

従って、実施の形態 2 と比較すると、高周波デバイスを小型化することができ、移動体通信機器への適用を広げることができるのはもちろん、積層セラミック回路基板 4 0 を形成した後、わざわざバリスタとインダクタを実装する必要が無いので生産性に優れたものとなる。

【 0 0 3 6 】

なお、上記実施の形態 1 ～ 3 においては、バリスタ 2 1 とインダクタ 2 2 はアンテナ端子 1 0 と移相器 1 4 との間に設けたが、S A W フィルタ 1 2, 1 3 とアンテナ端子 1 0 との間に並列にかつ一端がグランド端子 2 3 に接続されるように形成すれば構わない。しかしながら、上記実施の形態に示すように回路的に見てアンテナ端子 1 0 に近い位置にバリスタ 2 1 とインダクタ 2 2 を接続することにより、共用器 1 1 以降の回路の保護を確実に行うことができるので望ましい。

【 0 0 3 7 】

また、上記各実施の形態においては、G S M システムへの応用を例に説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば P D C や A M P S システムでも、デュアルバンド、トリプルバンドであっても、アンテナ端子 1 0 から侵入する高電圧雑音に対する対策の必要なものについては、アンテナ端子 1 0 とこのアンテナ端子 1 0 に接続する回路との間に並列にバリスタ 2 1 およびインダクタ 2 2 を接続し、その一端をグランド端子 2 3 に接続することにより同様の効果が得られるものである。

【 0 0 3 8 】

また、上記各実施の形態においては、共用器 1 1 として移相器 1 4 と S A W フィルタ 1 2, 1 3 を用いたものを例に説明したが、フィルタは一方もしくは両方が誘電体フィルタであっても構わない。

【 0 0 3 9 】

【発明の効果】

以上本発明によると、信号通過帯域に近い周波数の高電圧雑音がアンテナ端子から侵入したとしても、後に接続された回路を確実に保護することのできる高周波デバイスを提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の実施の形態 1 ～ 3 における高周波デバイスの回路ブロック図

【図 2】

本発明の実施の形態 2 における高周波デバイスの断面図

【図 3】

本発明の実施の形態 3 における高周波デバイスの断面図

【図 4】

比較のための高周波デバイスの回路図

【図 5】

本発明の実施の形態 1 における高周波デバイスの静電気除去特性を示すグラフ

【図 6】

図 7 に示す高周波デバイスの静電気除去特性を示すグラフ

【図 7】

従来の高周波デバイスの回路図

【符号の説明】

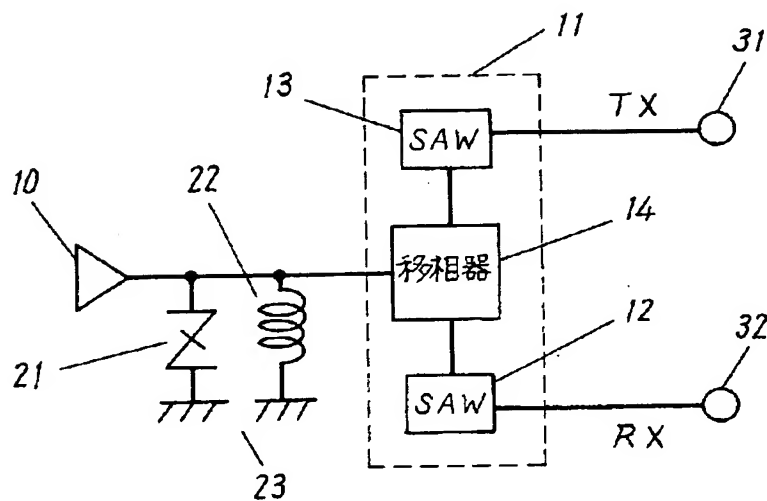
- 1 0 アンテナ端子
- 1 1 共用器
- 1 2 SAWフィルタ
- 1 3 SAWフィルタ
- 1 4 移相器
- 1 8 SAWフィルタ
- 2 1 バリスタ
- 2 2 インダクタ

- 2 3 グランド端子
- 3 1 送信側端子
- 3 2 受信側端子
- 4 0 積層セラミック基板
- 4 1 セラミック層
- 4 2 導体パターン
- 4 3 ふた
- 4 4 セラミック層
- 4 5 内部電極
- 5 0 ハイパスフィルタ
- 5 1 インダクタ
- 5 2 コンデンサ

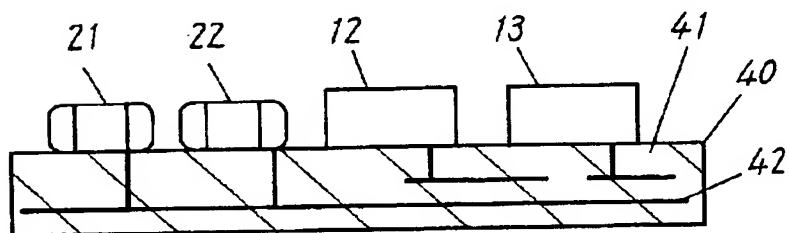
【書類名】 図面

【図 1】

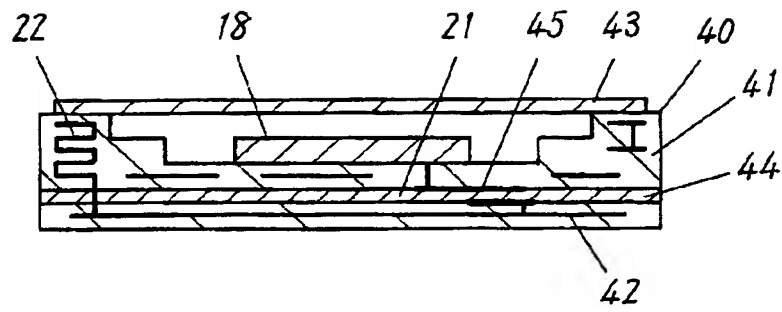
- | | | | | | |
|-------|---------|----|--------|----|-------|
| 10 | アンテナ端子 | 21 | バリスタ | 31 | 送信側端子 |
| 11 | 共用器 | 22 | インダクタ | 32 | 受信側端子 |
| 12,13 | SAWフィルタ | 23 | グランド端子 | | |



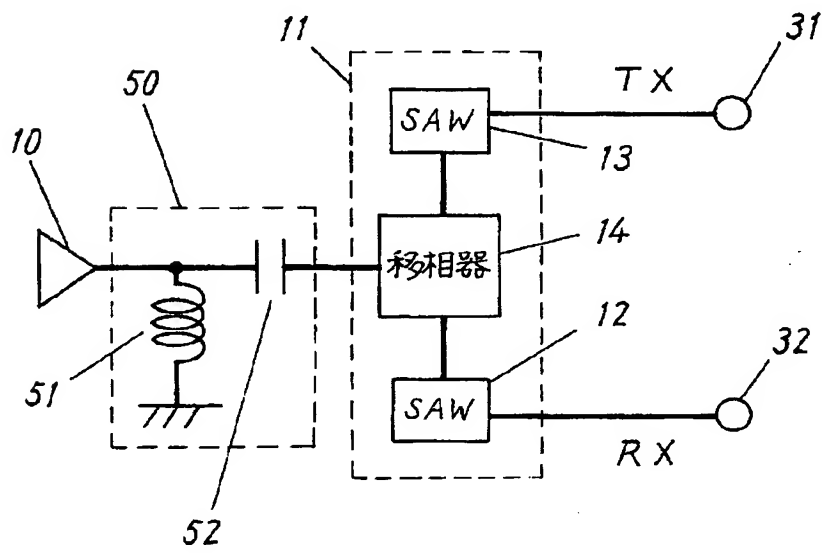
【図 2】



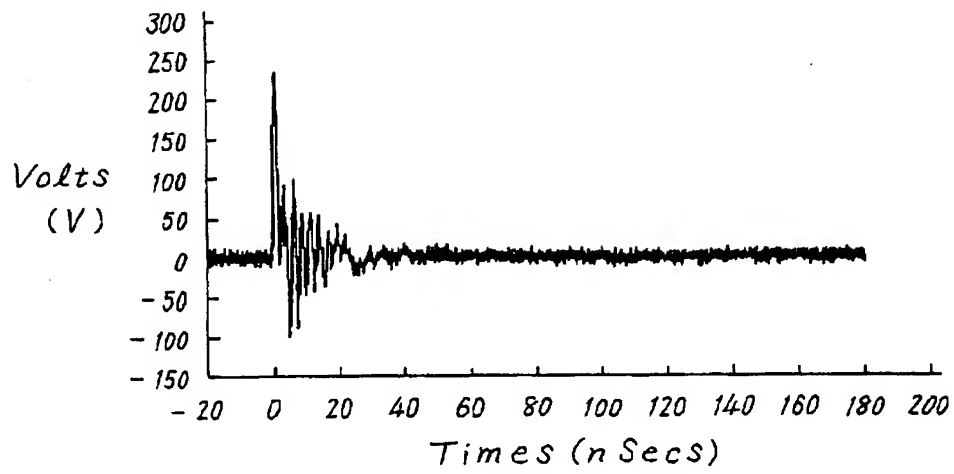
【図 3】



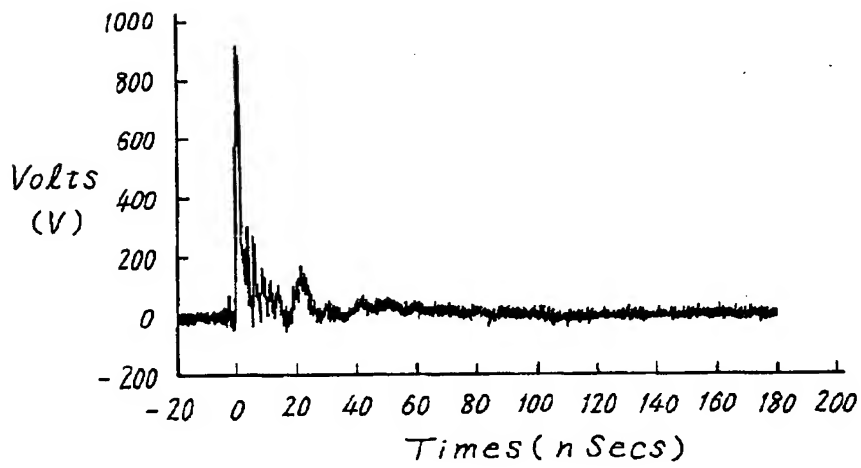
【図 4】



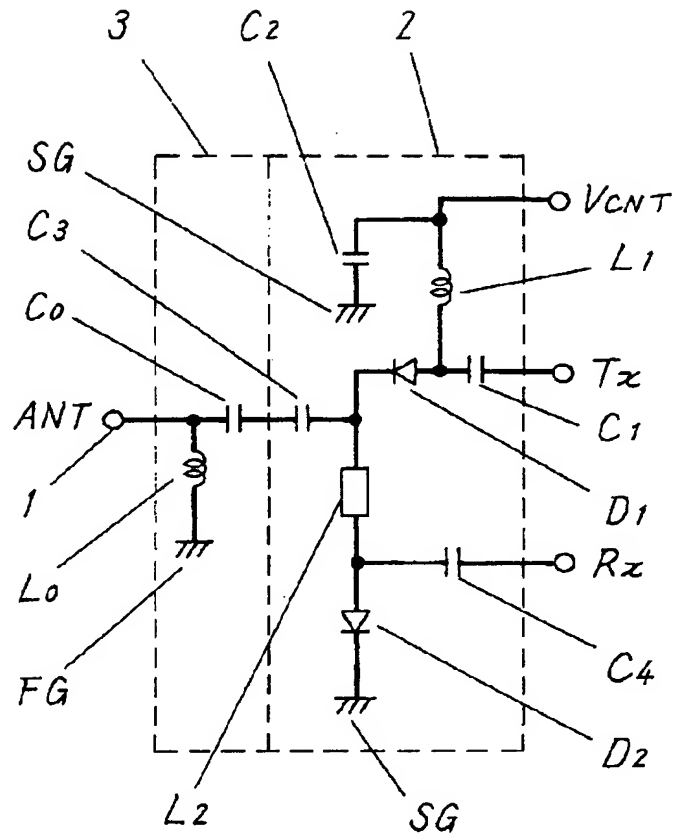
【図 5】



【図 6】



【図7】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 静電気のような信号通過帯域に近い周波数の高電圧雑音が侵入したとしても、アンテナ端子の後に接続された回路を保護することのできる高周波デバイスを提供することを目的とする。

【解決手段】 アンテナ端子 1 0 に接続した共用器 1 1 を備え、アンテナ端子 1 0 と共用器 1 1 間の信号ラインと並列にバリスタ 2 1 およびインダクタ 2 2 を接続したものである。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 5 8 2 1]

1. 変更年月日	1 9 9 0 年 8 月 2 8 日
[変更理由]	新規登録
住 所	大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地
氏 名	松下電器産業株式会社